

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-285509  
(43)Date of publication of application : 13.10.2000

(51)Int.Cl. G11B 7/24

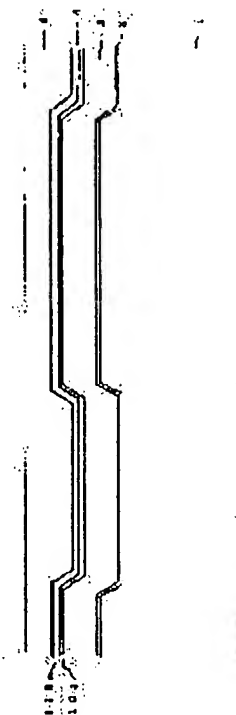
(21)Application number : 11-095005 (71)Applicant : RICOH CO LTD  
(22)Date of filing : 01.04.1999 (72)Inventor : KINOSHITA MIKIO  
HARIGAI MASATO  
SHIBAKUCHI TAKASHI

## (54) DRAW TYPE OPTICAL RECORDING MEDIUM

### (57)Abstract:

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To provide an optical recording medium using inorganic recording materials and having recording density equal to that of DVD-ROM.

**SOLUTION:** The optical recording medium has at least a light interference layer 3 on a translucent layer on a substrate 1 and a recording layer 4 on the light interference layer. The recording layer has a 1st recording layer 104 comprising a metal, a metalloid or an alloy of these and a 2nd recording layer 105 comprising Ge. The material of the 1st recording layer is, e. g. Al, Au, Ag, Cu, Pt, Pd, Sb, Te, In, Sn, Zn or the like, its compound or alloy. The translucent layer is, e.g. a thin film of Al, Au or Si. The light interference layer comprises known derivatives such as ZnS.SiO<sub>2</sub>, SiO<sub>2</sub>, MgF, SiN, InO or ZnO.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-285509

(P2000-285509A)

(43) 公開日 平成12年10月13日 (2000.10.13)

(51) Int.Cl.

G11B 7/24 (522)

F I

G11B 7/24 (522B) 5D029

511

511

535

535C

535G

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全6頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願平11-95005

(22) 出願日 平成11年4月1日 (1999.4.1)

(71) 出願人 000006747

株式会社リコー

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

(72) 発明者

木下 幹夫

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式  
会社リコー内

(72) 発明者

針谷 眞人

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式  
会社リコー内

(74) 代理人

100078994

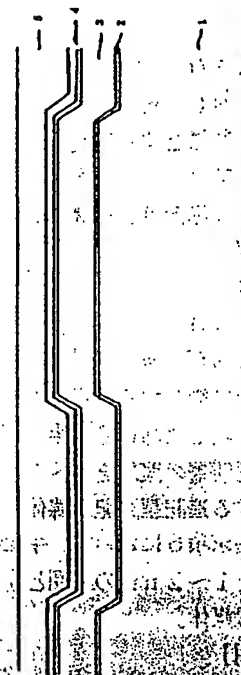
弁理士 小松 秀岳 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 追記型光記録媒体

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 DVD-ROMと等容量の記録密度をもつ、無機系の記録材料を用いた光記録媒体を提供する。

【解決手段】 基板1上の半透明層上の光干渉層3、該光干渉層上の記録層4を少なくとも有し、かつ、該記録層が金属または半金属あるいはこれらの合金から成る第1記録層104とGeから成る第2記録層105とを有することを特徴とする追記型光記録媒体である。第1記録層の材質は、Al、Au、Ag、Cu、Pt、Pd、Sb、Te、In、Sn、Zn等で、化合物や合金を含む。半透明層は、Al薄膜、Au薄膜、Si薄膜などである。光干渉層は、ZnS、SiO<sub>2</sub>、SiO<sub>2</sub>、MgF、SiN、InO、ZnO等公知の誘導体である。

(2) 000-285509 (P2000-285509A)

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上の半透明層、該半透明層上の光干渉層、該光干渉層上の記録層を少なくとも有し、かつ、該記録層が金属、または半金属、あるいはこれらの合金から成る第1記録層とGeから成る第2記録層とを有することを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項2】 請求項1においてモジュレーションが60%以上であることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項3】 請求項1または2において第1記録層をAu、Cu、Agあるいはこれらの合金とし、かつ、該第1記録層の膜厚を30nm以下の範囲とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項4】 請求項1または2において第1記録層をAlあるいはこれらの合金とし、かつ、該第1記録層の膜厚を20nm以下とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項5】 請求項3または4において、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い側に第1記録層が配置され、記録マーク部分の反射率が低下することを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項6】 請求項2、3、4、または5において光干渉層の屈折率を $n$ 、膜厚を $d$ 、記録波長を $\lambda$ と表す表式において、これらが、

$$1.9 \leq n \leq 2.5$$

$$0.25 \leq nd/\lambda \leq 0.35$$

$$600 \text{ nm} \leq \lambda \leq 680 \text{ nm}$$

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項7】 請求項2、3、4または5において光干渉層の屈折率を $n$ 、膜厚を $d$ 、記録波長を $\lambda$ と表す表式において、これらが、

$$1.4 \leq n < 1.6$$

$$0.33 \leq nd/\lambda \leq 0.41$$

$$600 \text{ nm} \leq \lambda \leq 680 \text{ nm}$$

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項8】 請求項2、3、4または5において光干渉層の屈折率を $n$ 、膜厚を $d$ 、記録波長を $\lambda$ と表す表式において、これらが、

$$1.6 \leq n \leq 1.9$$

$$0.31 \leq nd/\lambda \leq 0.37$$

$$600 \text{ nm} \leq \lambda \leq 680 \text{ nm}$$

の範囲にあることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項9】 請求項6において、半透明層をAuまたはAgとし、該半透明層の膜厚を5~15nmの範囲とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【請求項10】 請求項6において、半透明層をAlとし、該Alの膜厚を1~2nmの範囲とすることを特徴とする追記型光記録媒体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、レーザービームな

2

どの照射により記録再生が可能な追記型光記録媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】 レーザービームの照射による記録可能な光記録媒体としてCD-R、DVD-R等の追記型光記録媒体などがある。これらの相変化光記録媒体はCD-ROMあるいはDVD-ROMと再生互換性があり、小規模の配布メディアや保存用の媒体として使用されている。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】 特に大容量メディアであるDVD-ROMと等容量の記録密度の実現が課題となっている。この幅広い普及を図る上で、高記録密度での記録パワーマージンの確保が特に重要な課題である。この確保に関しては、相変化記録材料、合金化可能な2層膜など無機系の記録材料が有利であるが、モジュレーションの不足、あるいはDVD-ROMなどDPD (Differential Phase Detection) を使用するドライブのトラッキング信号強度が不足する等の問題があった。特に、特開平6-171236に開示されるAl-Ge<sub>2</sub>層膜では熱処理後の反射率が上昇するが、ROM互換を実現する上では、熱処理後の反射率を低下させ、かつ、上記60%以上のモジュレーションを得ることがAlGe<sub>2</sub>層膜を使用する光記録媒体の課題となっていた。

【0004】

【課題を解決するための手段】 本発明による追記型光記録媒体は、基板上の半透明層、この上の光干渉層、光干渉層上の記録層を少なくとも有する。記録層は金属、半金属あるいはこれらの合金から成る第1記録層と、第1記録層と合金化可能なGeから成る第2記録層を有する。

【0005】 第1記録層の材質は、Al、Au、Ag、Cu、Pt、Pd、Sb、Te、In、Sn、Zn等で、化合物や合金を含む。基板の材質はポリカーボネート、ガラスなどの公知の透明体で、この上の半透明層は、半透明Al薄膜、半透明Au薄膜、半透明Si薄膜など、吸収を有する材質で、所定の透過率、反射率を有する半透明体である。相変化材料も半透明層として使用可能である。光干渉層はZnS・SiO<sub>2</sub>、SiO<sub>2</sub>、MgF、Si-N、In-O、Zn-O等公知の誘電体である。本発明の第2は、上記において、モジュレーションが60%以上のものが該当する。

【0006】 請求項3に記載の追記型光記録媒体では、第1記録層をAu、Cu、Agあるいはこれらの合金とし、第1記録層の膜厚を30nm以下とする。請求項4に記載の追記型光記録媒体では、第1記録層をAlあるいはこれらの合金とし、この第1記録層の膜厚を20nm以下の範囲とする。

【0007】 さらに、請求項5に記載の追記型光記録媒体

体では、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い側に第1記録層が配置され、記録マーク部分の反射率が低下する構成となっている。

【0008】本発明の第6は、本発明の2、3、4または5において光干渉層の屈折率を $n$ 、膜厚を $d$ 、記録波長を $\lambda$ と表す表式において、これらが

$$1.9 \leq n \leq 2.5$$

$$0.25 \leq n d / \lambda \leq 0.35$$

$$600\text{ nm} \leq \lambda \leq 680\text{ nm}$$

の範囲にあることを特徴とする。 10

【0009】本発明の第7は、本発明の第2、3、4または5において光干渉層の屈折率を $n$ 、膜厚を $d$ 、記録波長を $\lambda$ と表す表式において、これらが、

$$1.4 \leq n < 1.6$$

$$0.33 \leq n d / \lambda \leq 0.41$$

$$600\text{ nm} \leq \lambda \leq 680\text{ nm}$$

の範囲にあることを特徴とする。

【0010】本発明の第8は、本発明の第2、3、4、または5において光干渉層の屈折率を $n$ 、膜厚を $d$ 、記録波長を $\lambda$ と表す表式において、これらが、

$$1.6 \leq n < 1.9$$

$$0.31 \leq n d / \lambda \leq 0.37$$

$$600\text{ nm} \leq \lambda \leq 680\text{ nm}$$

の範囲にあることを特徴とする。

【0011】本発明の第9は、本発明の第6において、半透明層をAuまたはAgとし、該半透明層の膜厚を5～16 nmの範囲とすることを特徴とする。本発明の第10は、本発明の第6において、半透明層をAlとし、該Alの膜厚を1～2 nmの範囲とすることを特徴とする追記型光記録媒体である。

【0012】

【作用】本発明では、記録層の前面に、光干渉層が存在する。この光干渉層の作用は、モジュレーションと反射率の制御にあるが、基板と光干渉層との間に半透明層を介在させることにより上記作用が増加する。

【0013】好ましい光干渉層の膜厚と屈折率には、一定の関係がある。また、光吸収層としては、屈折率の実部が小さく、虚部が適度に大きいほど好ましいが、この光吸収層の膜厚の好適な範囲は、光吸収層の光学定数に強く依存する。

【0014】第1記録層及び第2記録層の積層順番は任\*

半透明層Au(1nm) 光干涉層ZnSSiO<sub>2</sub>(95nm)

	第1記錄層材料	第1記錄層厚度(nm)	第2記錄層Ge厚度(nm)	反射率(%)	反射率(%)
比較例1	AJ	10	0	22.5	0.0
實施例1	AJ	10	10	14.5	25.0
實施例3	AJ	10	20	21.5	50.0
實施例3	AJ	10	30	35.0	65.0
實施例4	AJ	10	50	30.5	77.3
實施例5	AJ	10	70	21.0	70.0
實施例6	AJ	10	100	30.1	78.1

【0018】表2に第1記録層104がAgの場合のモジュレーション、反射率の第1記録膜厚依存性を示す。Ag膜厚が30nmを上回る場合にはモジュレシ

\*意であるが、これにより、記録時の反射率変化が規定される。DVD-ROMとの互換をとるという観点からは、記録マーク部分の反射率を低下させる必要があり、これは、記録層の層構成が、読みとり光の入射面に近い側に第1記録層が配置される場合に実現する。この場合過度に第1記録層膜厚が大きき場合には、光吸収の低下、あるいは熱拡散の増大による記録感度の悪化、あるいは、ジッタの増加が問題になり、好ましい記録層膜厚には上限がある。また、第1記録層及び第2記録層の膜厚は、合金化前後の記録層による反射光の振幅及び位相差に関連するパラメータでありモジュレーション等に影響を与える。

【0015】

【発明の実施の形態】図1に本発明に使用される追記型光記録媒体の層構成を示す。ポリカーボネート基板1上に光吸収層2、光干渉層3、第1記録層104及び第2記録層105から成る記録層4、樹脂から成る環境保護層5が順次堆積されている。光吸収層2はAuまたはAlからなる。光干渉層3は $ZnS \cdot SiO_2$ または $SiO_2$ である。第1記録層104はAu、Ag、Cu、Al等である。第2記録層105はGeから成る。この構成では、記録後のマーク部の反射率は低下する。基板のトラックピッチは $0.74\mu m$ である。

【0016】表1に、本構成の追記型光記録媒体の記録波長635nm、記録線速7m/s、データビット長0.267 $\mu$ m/bitでの記録における反射率・モジュレーションの第2記録層膜厚依存性を示す。表1で、Auから成る光吸収層2の膜厚は7nm、ZnS・SiO<sub>2</sub>から成る光干渉層3の膜厚は95nm、Alから成る第1記録層104の膜厚は10nm、記録再生波長は635nmである。第2記録層105の膜厚が50nm近傍、及び100nm近傍で大きなモジュレーションが得られる。Geは屈折率の実部が大きく、吸収係数が比較的小さいため、Geそのものも干渉層として作用し、反射率やモジュレーション、及び記録状態と未記録状態の反射光の位相差に影響を与える。ジッタなどの改善のために、Ge層の上に付加的な放熱層、あるいは干渉層を堆積しても良い。

【0017】

【表1】

※ヨンは低下する。また、記録感度に関しては、熱伝導及び記録層の光吸収率の關係でA g膜厚が薄い場合の方が好ましい。即ち、A g第1記録層の膜厚が厚い場合に於

5

000(4) 000-285509 (P2000-285509A)

6

は、記録レーザービームの吸収が小さく、かつ、熱伝導による熱拡散が大きく、加熱に多大なエネルギーを要する。この点からもAg膜厚は30nm以下が好ましい。\*

半透明層Au:7nm、光干渉層ZnSSiO<sub>2</sub>95nm

\*【0019】

【表2】

比較例	第1記録層材料	第1記録層膜厚(nm)	第2記録層Ge膜厚(nm)	反射率(%)	モジュレーション(%)
比較例7	Ag	0	30	19.9	0.0
比較例8	Ag	5	30	21.0	66.7
比較例9	Ag	10	30	23.0	75.0
比較例10	Ag	15	30	34.3	71.4
比較例11	Ag	20	30	42.0	71.7
比較例12	Ag	30	30	51.8	75.2
		50	30	60.2	73.3

【0020】表3に、第1記録層がAlの場合のモジュレーション、反射率の第1記録層膜厚依存性を示す。AlはAgと比較して、吸収係数が大きく、モジュレーションの極大を与える膜厚は約20nmである。上記と同※

半透明層Au:7nm、光干渉層ZnSSiO<sub>2</sub>95nm

10※様に記録感度の観点からも、Al膜厚は20nm以下が好ましい。

【0021】

【表3】

比較例	第1記録層材料	第1記録層膜厚(nm)	第2記録層Ge膜厚(nm)	反射率(%)	モジュレーション(%)
比較例13	Al	5	30	25.2	42.8
比較例14	Al	10	30	35.0	68.0
比較例15	Al	15	30	42.0	70.0
比較例16	Al	20	30	43.4	71.0
比較例17	Al	30	30	44.8	68.8
比較例18	Al	50	30	46.2	59.1

【0022】表4に光干渉層を記録波長635nmでの屈折率が2.17であるZnS・SiO<sub>2</sub>薄膜とした場合の反射率、モジュレーションを示す。第1記録層はAl:10nmで、第2記録層はGe:30nmである。光干渉層の膜厚85nm付近にモジュレーションの極大★

第1記録層Al:10nm、第2記録層Ge:30nm

20★値があり、nd/λが0.25~0.35の範囲でモジュレーションは60%以上となる。

【0023】

【表4】

比較例	半透明層Au膜厚(nm)	光干渉層ZnSSiO <sub>2</sub> 膜厚(nm)	nd/λ	反射率(%)	モジュレーション(%)
比較例19	7	65	0.198	45.5	44.8
比較例20	7	67	0.212	39.2	55.4
比較例21	7	75	0.256	32.9	61.7
比較例22	7	85	0.290	32.9	72.3
比較例23	7	85	0.325	35.0	68.0
比較例24	7	105	0.350	42.7	59.0
比較例25	7	115	0.383	49.0	50.0

【0024】表5に光干渉層を記録波長635nmでの屈折率が1.457であるSiO<sub>2</sub>薄膜とした場合の反射率、モジュレーションを示す。光干渉層の膜厚160nm付近にモジュレーションの極大値があり、nd/λ☆

第1記録層Al:10nm、第2記録層Ge:30nm

☆が0.33~0.41の範囲でモジュレーションは60%以上となる。

【0025】

【表5】

比較例	半透明層Au膜厚(nm)	光干渉層SiO <sub>2</sub> 膜厚(nm)	nd/λ	反射率(%)	モジュレーション(%)
比較例26	10	130	0.298	42.0	50.0
比較例27	10	145	0.333	35.0	60.0
比較例28	10	160	0.367	35.0	64.0
比較例29	10	175	0.402	38.5	63.8
比較例30	10	190	0.436	49.0	45.7

【0026】表6に光干渉層を記録波長635nmでの屈折率が1.766であるAl<sub>2</sub>O<sub>3</sub>薄膜とした場合の反射率、モジュレーションを示す。光干渉層の膜厚120nm付近にモジュレーションの極大値があり、nd/λ◆

第1記録層Al:10nm、第2記録層Ge:30nm

40◆が0.31~0.37の範囲でモジュレーションは60%以上となる。

【0027】

【表6】

比較例	半透明層Au膜厚(nm)	光干渉層Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> 膜厚(nm)	nd/λ	反射率(%)	モジュレーション(%)
比較例31	8	90	0.250	41.3	44.1
比較例32	8	100	0.276	39.5	52.7
比較例33	8	110	0.306	35.0	59.0
比較例34	8	120	0.334	35.0	64.0
比較例35	8	130	0.362	37.1	62.3
比較例36	8	140	0.389	43.4	54.8
比較例37	8	150	0.417	49.7	49.2

【0028】表7に半透明層をAuとした場合の反射率\*50%、モジュレーションの半透明層膜厚依存性を示す。記



000(5) 000-285509 (P2000-285509A)

7

8

録層は第1記録層がAl:10nm、第2記録層がGe \* 【0029】  
e:30nmである。Au膜厚5~15nmでモジュレ 【表7】  
ーションは60%を上回る。

第1記録層Al:10nm、第2記録層Ge:30nm

	半透明層Au膜厚(nm)	光干渉層ZnSS:O <sub>2</sub> 膜厚(nm)	nd/λ	反射率(%)	モジュレーション(%)
比較例3	0	95	0.325	50.4	50.0
実施例38	3	95	0.325	44.1	55.8
実施例39	5	95	0.325	38.3	63.6
実施例40	7	95	0.325	35.0	68.0
実施例41	10	95	0.325	28.8	76.3
実施例42	15	95	0.325	18.8	81.3
実施例43	20	95	0.325	11.8	88.8

【0030】表Sに半透明層をA1とした場合の、反射率、モジュレーションの半透明層膜厚依存性を示す。記録層は、第1記録層がAl:10nm、第2記録層がGe:30nmである。Al膜厚1~2nmでモジュレーションは60%を上回る。これ以外に、AgInSbTe、GeSbTeなどの相変化材料も半透明層として使※

10※用可能であるが、この場合、半透明層は記録時の熱エネルギーにより結晶化するので、光学定数が変化し、補助的な記録層としての作用も有する。

【0031】

【表8】

第1記録層Al:10nm、第2記録層Ge:30nm

	半透明層Al膜厚(nm)	光干渉層ZnSS:O <sub>2</sub> 膜厚(nm)	nd/λ	反射率(%)	モジュレーション(%)
比較例3	0	95	0.325	50.4	50.0
実施例44	1	95	0.325	22.8	64.8
実施例45	2	95	0.325	15.8	63.6
実施例46	3	95	0.325	7.0	40.0
実施例47	5	95	0.325	12.8	0.0

【0032】以上のように本発明では、Geと合金化可能な第1記録層を有する光記録媒体において、記録状態の反射率が低下する層構成で、モジュレーション60%以上を得た。なお、本発明に使用される光記録媒体の層構成は上記に限られず、公知の光記録媒体の任意の構造が可能である。

【0033】

【発明の効果】本発明は上記のごとくしたが故に以下の効果が生じた。パワーマージンに優れた無機系追記型光記録媒体のモジュレーションが向上し、DVD-ROM等の汎用ドライブで再生可能な追記型光記録媒体を得★

★た。

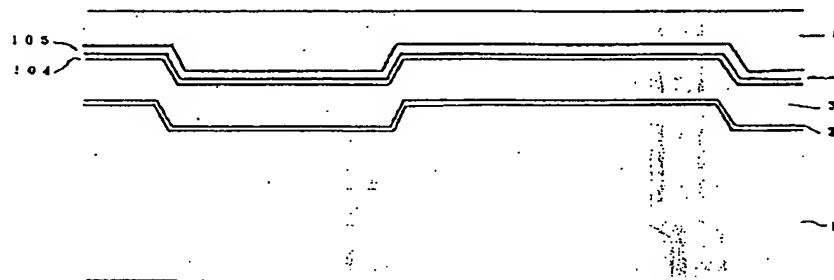
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の追記型光記録媒体の層構成を示す。

【符号の説明】

- 1 ポリカーボネート基板
- 2 光吸収層
- 3 光干渉層
- 4 記録層
- 5 環境保護層
- 104 第1記録層
- 105 第2記録層

【図1】



(6) 000-285509 (P2000-285509A)

フロントページの続き

(51)Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	ターム(参考)
G11B 7/24	538	G11B 7/24	538A

(72)発明者 芝口 孝  
東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式  
会社リコー内

Fターム(参考) 5D029 JA01 JB03 JB17 JB35 JC20  
LB01 LB07 LC06 MA02 MA03